

2SA564, 2SA564A

2SA564, 2SA564A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ型/Si PNP Epitaxial Planar

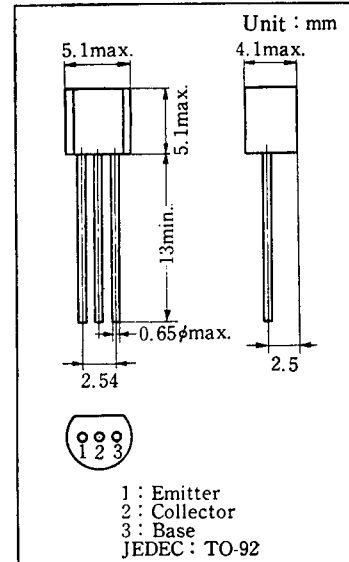
一般増幅用/General Use for Small Signal
2SC828, 2SC828A とコンプリメンタリ/Complementary pair with
2SC828, 2SC828A

特徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きい。/High h_{FE}
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。/Low $V_{CE(sat)}$

最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| Item | Symbol | Value | Unit |
|-------------|------------|----------|------------------|
| コレクタ・ベース電圧 | $-V_{CBO}$ | 25 | V |
| | | 45 | |
| コレクタ・エミッタ電圧 | $-V_{CEO}$ | 25 | V |
| | | 45 | |
| エミッタ・ベース電圧 | $-V_{EBO}$ | 5 | V |
| せん頭コレクタ電流 | $-I_{CM}$ | 100 | mA |
| コレクタ電流 | $-I_C$ | 50 | mA |
| コレクタ損失 | P_C | 250 | mW |
| 接合部温度 | T_j | 125 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度 | T_{stg} | -55~+125 | $^\circ\text{C}$ |



電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| Item | Symbol | Condition | min. | typ. | max. | Unit |
|---------------|----------------|--|------|-------|------|---------------|
| コレクタ・ベース電圧 | $-V_{CBO}$ | $-I_C=10\mu\text{A}$ | 25 | | | V |
| | | | 45 | | | |
| コレクタ・エミッタ電圧 | $-V_{CEO}$ | $-I_C=2\text{mA}$ | 25 | | | V |
| | | | 45 | | | |
| エミッタ・ベース電圧 | $-V_{EBO}$ | $-I_E=10\mu\text{A}$ | 5 | | | V |
| コレクタシャ断電流 | $-I_{CBO}$ | $-V_{CB}=10\text{V}, I_E=0$ | | 0.001 | 1 | μA |
| コレクタシャ断電流 | $-I_{CEO}$ | $-V_{CE}=25\text{V}$ | | | 10 | μA |
| | | $-V_{CE}=45\text{V}$ | | | 10 | |
| 直流電流増幅率 | h_{FE}^* | $-V_{CB}=5\text{V}, I_E=2\text{mA}$ | 65 | 250 | 700 | |
| トランジション周波数 | f_T | $-V_{CB}=10\text{V}, I_E=1\text{mA}$ | | 80 | | MHz |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $-V_{CE(sat)}$ | $-I_C=50\text{mA}, -I_B=2.5\text{mA}$ | | 0.3 | | V |
| コレクタ出力容量 | C_{ob} | $-V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$ | | 2.7 | | pF |

* h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

| h_{FE} | 65~130 | 90~180 | 130~260 | 180~360 | 260~520 | 360~700 |
|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 分類 | O | P | Q | R | S | T |